

性能特点：

- RF/LO 频段：0.7GHz~2GHz
- IF 频段：DC~1GHz
- 变频损耗：10dB
- RF-IF 隔离度：13dB
- LO-IF 隔离度：30dB
- LO-RF 隔离度：32dB
- 本振功率：-7dBm
- 功耗：5V/58mA
- 芯片尺寸：3.1mm×2.0mm×0.1mm

产品简介：

HH-FC00702 是一种 GaAs MMIC 变频多功能芯片，芯片内部集成了本振驱动放大器，射频/本振频率覆盖 0.7~2GHz，中频频率覆盖 DC~1GHz，典型本振输入功率为-7dBm。

电参数： (TA=25°C,IF=0.1GHz,LO=-7dBm)

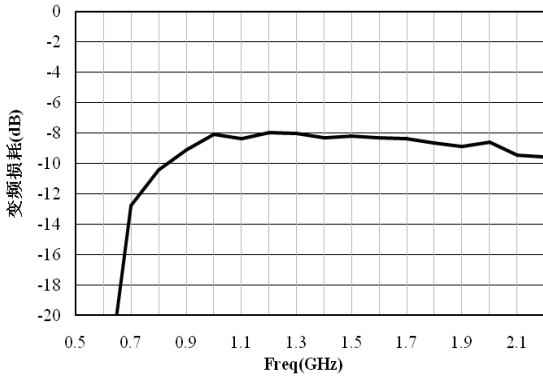
| 指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|-------|-----|-----|-----|
| 射频频率 | 0.7~2 | | | GHz |
| 本振频率 | 0.7~2 | | | GHz |
| 中频频率 | DC~1 | | | GHz |
| 变频损耗 | 8 | 10 | 13 | dB |
| RF-IF 隔离度 | 10 | 13 | 15 | dB |
| LO-IF 隔离度 | 25 | 30 | 40 | dB |
| LO-RF 隔离度 | 25 | 32 | 39 | dB |
| P1dB(input) | 10 | 12 | 14 | dBm |

使用限制参数：

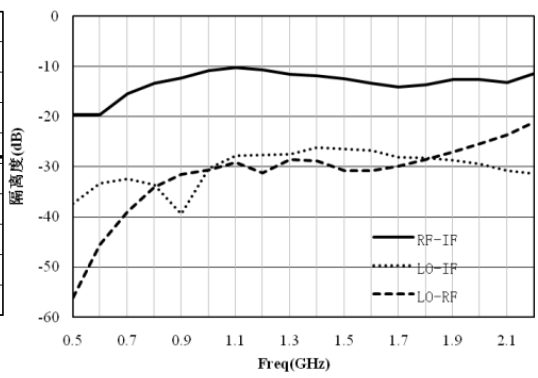
| | |
|---------|-------------|
| 射频/中频功率 | 20 dBm |
| 本振功率 | 5 dBm |
| 存储温度 | -65°C~150°C |
| 使用温度 | -55°C~125°C |

典型曲线：

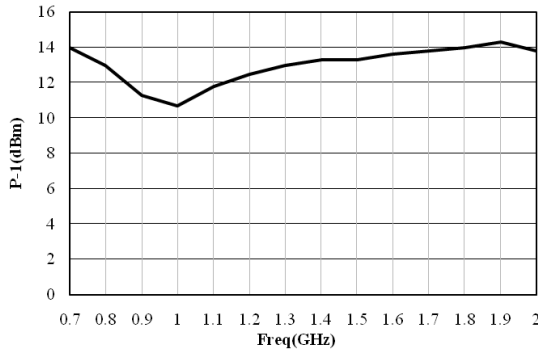
变频损耗曲线@LO=-7dBm,中频频率 0.1GHz



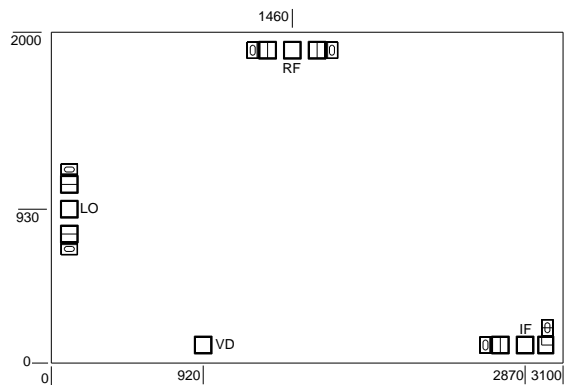
隔离度@LO=-7dBm,中频频率 0.1GHz



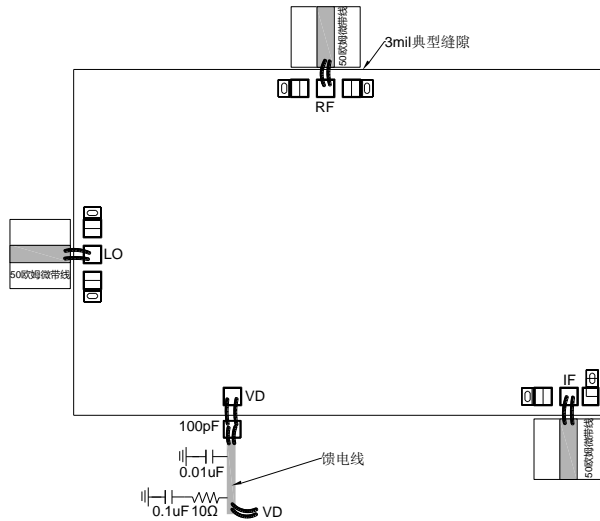
输入 P-1@LO=-7dBm



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）